
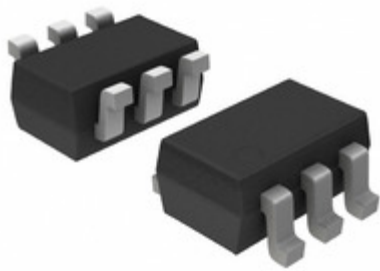



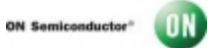
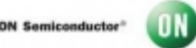


	<h2 style="color: red;">NVJS4151PT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVJS4151PT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.2A SC88</p> <p>Datenblätter:  NVJS4151PT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVJS4151PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.2A SC88
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	67 mOhm @ 2.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



NVJS4151PT1G ist neu im Original, Suche NVJS4151PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVJS4151PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVJS4151PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVJD4158CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVJD4158CT1G ON</p>	 <p>NVJS4405NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1.2A SC88</p>	 <p>HUFA76437P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 71A TO-220AB</p>	 <p>AUJRF1405ZSTRL International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 150A D2PAK</p>
 <p>NVJD4152PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVJD4152PT1G ON</p>	 <p>NVJS3151PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVJS3151PT1G ON</p>	 <p>NVJD4401NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SC88</p>	 <p>FMD40-06KC IXYS Corporation MOSFET N-CH 600V 38A I4-PAC-5</p>

heiße Teile

Mehr

 08055A390GAT4A	 218N04ZZA05G	 AO4407A.	 BA10358F	 BR93LC56AF-FE2
 BZX84C5V6	 C2012C0G2E392J125AA	 CM2576ZJCN263TR	 DB2130300L	 FMMT619-L
 FS150R12PT4	 FTSH-102-01-F-DV-TR	 IRL2505STRR	 LQH43MN681J01L	 LTC1147IS8-3.3
 MA27V020S1TD	 MAX846AEEEE-T	 MIC5319YML	 MIG30J906HA	 MMBT4354
 MMPF0100NPEP	 NLAS3699BMN1R2G	 NVJD4152PT1G	 NVJD4158CT1G	 NVJD4401NT1G
 NVJD5121NT1G	 NVJS3151PT1G	 D NVJS4405NT1G	 OPA2316IDGKR	 P2800ECL
 PDH1008C	 PDTA124EU	 RB886GT2R	 RT9818C-27GV	 S-1711A2828-I6T1G
 S2121BHA	 SB3602EA3-P	 SI5435BDC-T1-GE3	 SI9113DY-T1-E3	 SKM75GB063D
 SPC560P50L3BEABR	 STM32F103RET6	 TD430N04KOF	 TPS72525DCQ	 UPB1510GV-E1
 V24A5C400AN2	 VE-J6M-EW	 VF30120S-E3/4W	 WM8955LEFL	 XC6108N08AMR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited